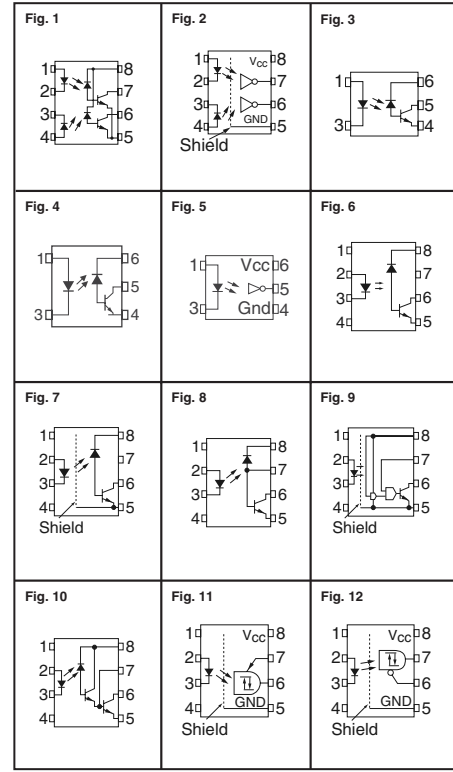


Fig.	Boîtier	Courant de sortie			Débit typique (bit/s)	Tension d'alimentation max. (V)	Tension d'isolement (V eff.)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Digi-Key	Bande et bobine	
		Min. (mA)	à If (mA)	à VO (V)					1	10	100		Qté	Prix
1	Dip	1.12	16	0.4	1M	15	2,500	TLP2530F-ND	2.29	1.83	1.43	—	—	—
	Dip	3.04	16	0.4	1M	15	2,500	TLP2531F-ND	2.29	1.83	1.43	—	—	—
2	Dip	16	5	0.6	10M	5.5	2,500	TLP2630F-ND	1.91	1.53	1.19	—	—	—
	Dip	13	5	0.6	10M	5.5	2,500	TLP2631F-ND	1.91	1.53	1.19	—	—	—
	SMD*	13	5	0.6	10M	5.5	2,500	TLP2631TP1FCT-ND	2.00	1.61	1.25	TLP2631TP1FTR-ND	1,500	1133.93/M
3	SMD	1.6	16	0.4	1M	15	2,500	TLP112FCT-ND	1.36	1.10	.82	TLP112FTR-ND	3,000	699.29/M
4	SMD	1.6	16	0.4	1M	15	2,500	TLP112AFCT-ND	1.52	1.22	.92	TLP112AFTR-ND	3,000	780.60/M
5	SMD	13	10	0.4	10M	5.5	2,500	TLP113FCT-ND	1.48	1.19	.89	TLP113FTR-ND	3,000	758.92/M
	SMD	13	10	0.4	10M	5.5	2,500	TLP115FCT-ND	2.34	1.87	1.46	—	—	—
	SMD	13	5	0.4	10M	5.5	2,500	TLP115AF-ND	3.20	2.79	2.08	—	—	—
	SMD	13	5	0.4	10M	5.5	2,500	TLP115AFCT-ND	6.11	4.89	3.67	TLP115AFTR-ND	3,000	1561.87/M
6	Dip	1.6	16	0.4	1M	15	2,500	TLP550-ND	1.17	.94	.70	—	—	—
	Dip	1.6	16	0.4	1M	15	2,500	TLP550F-ND	1.17	.94	.70	—	—	—
7	Dip	3.2	16	0.4	1M	15	2,500	TLP559F-ND	1.59	1.28	.96	—	—	—
	Dip	1.12	16	0.4	1M	15	2,500	6N135TF-ND	1.02	.85	.68	—	—	—
8	Dip	3.04	16	0.4	1M	15	2,500	6N136TF-ND	.81	.68	.55	—	—	—
	Dip	13	5	0.6	10M	5.5	2,500	6N137TF-ND	.81	.68	.55	—	—	—
9	Dip	13	5	0.6	10M	5.5	2,500	TLP2601F-ND	1.69	1.36	1.02	—	—	—
	SMD	13	5	0.6	10M	5.5	2,500	TLP2601TP1CT-ND	1.91	1.53	1.19	—	—	—
10	Dip	4.8	1.6	0.4	100K	18	2,500	6N138TF-ND	.91	.77	.61	—	—	—
	Dip	2	0.5	0.4	100K	18	2,500	6N139TF-ND	.81	.68	.55	—	—	—
11	Dip	25	1.6	0.5	5M	20	2,500	TLP558F-ND	3.05	2.44	1.90	—	—	—
	Dip	25	1.6	0.5	5M	20	2,500	TLP2200F-ND	2.10	1.68	1.31	—	—	—
12	SOP	25	1.6	0.5	5M	20	2,500	TLP2200CT-ND	2.24	1.79	1.39	TLP2200TR-ND	1,500	1265.68/M
	SOP	25	1.6	0.5	5M	20	2,500	TLP2200FCT-ND	2.24	1.79	1.39	TLP2200FTR-ND	1,500	1265.68/M

† Bande coupée ◆ Conforme à RoHS \* Plomb CMS



**Coupleurs photovoltaïques**

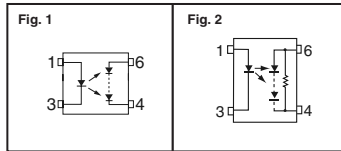


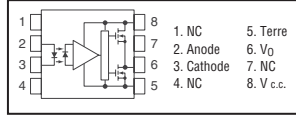
Fig.	Boîtier	Court-circuit		Tension ouverte typ. (V)	Temps de commutation (à UF=20 mA, CL=1 000 pF)		Tension d'isolement (V eff.)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Digi-Key	Bande et bobine	
		Min. (uA)	à If (mA)		T passant (ms)	T bloqué (ms)			1	10	100		Qté	Prix
1	MFSOP	12	10	8.0	0.2	2.0	2,500	TLP190BF-ND	2.10	1.68	1.31	—	—	—
2	MFSOP	24	20	8.0	0.2	2.0	2,500	TLP191BF-ND	2.29	1.83	1.43	—	—	—
		24	20	8.0	0.2	2.0	2,500	TLP191BFCT-ND	2.29	1.83	1.43	TLP191BFTR-ND	3,000	1280.67/M

† Bande coupée

**Opto-isolateurs industriels**



Caractéristiques : • Tension d'isolement : 3 750 V eff.  
• Température de fonctionnement : - 40 à 100 °C



Boîtier	Courant d'entrée		Tension directe	Fréq. fonct.	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Digi-Key	Bande et bobine	
	Min. (uA)	Max. (mA)				1	10	100		Qté	Prix
SMD	7.5	10	1.60	50kHz	TLP350TP1FCT-ND	2.02	1.61	1.21	TLP350TP1FTR-ND	1,500	1046.05/M
Dip	7.5	10	1.60	50kHz	TLP350F-ND	2.02	1.61	1.21	—	—	—

**Sorties du transistor de puissance**

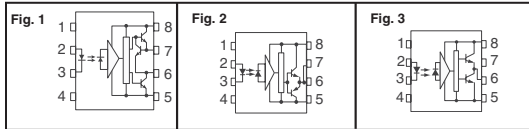
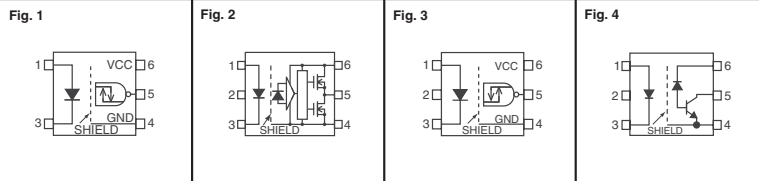


Fig.	Boîtier	Courant de sortie		Temps de propagation standard (us)	Tension d'alimentation maximale (V)	Tension d'isolement (Veff.)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence Digi-Key	Prix de bande et bobine 1 500
		Iq (A)	à If (mA)					1	10	100		
1	Dip	±0.32	5.0	1	16	2,500	TLP557F-ND	1.52	1.22	.92	—	—
2	SMD	±0.5	5.0	0.2	35	2,500	TLP250F-ND	1.59	1.28	.96	—	—
		±1.5	5.0	0.15 à 8 mA	35	2,500	TLP250LF1F-ND	1.91	1.53	1.15	—	—
	Dip	±1.5	5.0	0.15 à 8 mA	35	2,500	TLP250TP1FCT-ND	1.69	1.36	1.02	TLP250TP1FTR-ND	880.88/M
3	SMD	±0.4	5.0	0.25 à 8 mA	35	2,500	TLP251FCT-ND	1.59	1.28	.96	TLP251FTR-ND	825.83/M
		±0.4	5.0	0.25 à 8 mA	35	2,500	TLP251F-ND	1.48	1.19	.89	—	—

† Bande coupée

**Photocoupleurs CMS IR**



Les photocoupleurs CMS IR de Toshiba comprennent une diode électroluminescente GaAlAs et une photodiode intégrée rapide et à gain élevé.

**TLP102, TLP106** : ils conviennent à l'isolement des signaux de commande d'entrée des modules d'alimentation intelligents. Ils sont dotés d'un déclencheur Schmitt intégré ainsi qu'une synchronisation et une immunité aux transitoires de mode commun de 10 kV/us. **TLP116** : prévu pour l'isolement numérique de convertisseurs A/N et N/A, de récepteurs de ligne à grande vitesse, d'interfaces de système de microprocesseur ainsi que d'écrans plasma. **TLP701, TLP705** : conviennent aux circuits d'entraînement de porte IGBT ou MOSFET de puissance. Apte à l'entraînement « direct » de portes IGBT de faible puissance. **TLP706** : type tampon logique. Pour les inverseurs logiques, TLP702 est aligné. **TLP702** : type inverseur logique. Pour les tampons logiques, TLP706 est aligné. **TLP716** : 50 % inférieur aux boîtiers DIL 8 broches et est conforme à la classe d'isolement renforcé des normes de sécurité, de sorte que le matériel de la surface de montage exigé par ces normes de sécurité peut être réduit. **TLP719** : possède un blindage Faraday intégré sur la puce du photodétecteur afin de fournir un mode commun d'immunité transitoire de bruit. Il convient aussi aux applications en milieu bruyant.

Fig.	Description	Débit de données (NRZ) (typ.)	Rapport de transfert de courant			Tension d'isolement BV à 1 min. (VDRM)	Type de boîtier	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire de bande coupée			Bande et bobine†		N° de référence Toshiba
			Iq	à If	à If				1	10	100	Qté	Prix	
1	Type d'inverseur logique (sortie en totem pôle)	250 ns	Pour les tampons de type logique, TLP106 est aligné.			3,750	MFSOP-6	TLP102FCT-ND	1.69	1.36	1.02	3,000	867.33/M	TLP102 (TRP,F)
	Type de tampon logique (sortie en totem pôle)	250 ns	Pour les inverseurs de type logique, TLP102 est aligné.			3,750	MFSOP-6	TLP106FCT-ND	1.69	1.36	1.02	3,000	867.33/M	TLP106 (TRP,F)
	Rapide	20 MBd	Inverseur logique (sortie en totem pôle)			3,750	MFSOP-6	TLP116FCT-ND	2.86	2.29	1.78	3,000	1600.83/M	TLP116 (TPR,F)
2	IGBT de faible puissance/entraînement direct de MOSFET	250 ns	Crête +/-0.6 A (maximum)			5,000	6-SMD	TLP701FCT-ND	1.61	1.29	.97	1,500	836.84/M	TLP701 (TP,F)
	IGBT de faible puissance/entraînement direct de MOSFET	100 ns	Crête +/-0.45 A (maximum)			5,000	6-SMD	TLP705FCT-ND	1.86	1.50	1.12	1,500	968.97/M	TLP705 (TP,F)
3	Type de tampon logique (sortie en totem pôle)	250 ns	IFHL = 5 mA (max), pour les inverseurs de type logique, TLP702 est aligné.			5,000	6-SMD	TLP706FCT-ND	1.52	1.22	.92	1,500	792.80/M	TLP706 (TP,F)
	Type d'inverseur logique (sortie en totem pôle)	250 ns	IFHL = 5 mA (max), pour les tampons de type logique, TLP706 est aligné.			5,000	6-SMD	TLP702FCT-ND	1.52	1.22	.92	1,500	792.80/M	TLP702 (TP,F)
	Rapide	20 MBd	—			5,000	6-SMD	TLP716FCT-ND	2.29	1.83	1.43	1,500	1295.92/M	TLP716 (TP,F)
4	Tension d'isolement élevée	1 Mbit/s	20 % (min.) à If = 16 mA			5,000	6-SMD	TLP719FCT-ND	1.57	1.26	.95	1,500	814.82/M	TLP719 (TP,F)

† Pour obtenir le numéro de référence de bande et bobine, remplacer CT-ND par TR-ND. ‡ Homologué UL. †† Sortie, non inverseur

DigiReel® La plupart des composants à découper à technologie CMS sont disponibles sur une DigiReel®. Pour connaître la référence bobine DigiReel, modifier 1-ND en 6-ND ou CT-ND en DKR-ND. Voir les services Digi-Key® en page 2 pour plus d'informations.

**Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.**

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

(FR091) 2385